# SHORT-CIRCUITING METHOD FOR CLOSED CIRCUIT FORMING ELECTRODE

Patent Number:

JP6232537

Publication date:

1994-08-19

Inventor(s):

YONEZAWA MASAO; others: 01

Applicant(s):

MURATA MFG CO LTD

Requested Patent:

□ JP6232537

Application Number: JP19930015411 19930202

Priority Number(s):

IPC Classification:

H05K3/22; H01L21/82; H01L23/12

EC Classification:

Equivalents:

## Abstract

PURPOSE: To enable a pair of electrodes to be surely short-circuited by a method wherein a pair of closed circuit forming trapezoidal electrodes are formed making their long sides confront each other, and solder paste is printed covering a region larger than the electrodes in area and fused by heating.

CONSTITUTION: When a wiring pattern is formed on a board, a set of closed circuit forming trapezoidal electrodes 2 and 2 whose short sides are joined to wiring patterns 1 and 1 respectively are formed so as to make their long sides confront each other interposing a prescribed gap between them. Fine pitch solder paste 3 is printed covering a region larger than the electrodes 2 and 2 in area. Thereafter, when solder paste 3 is fused by heating, solder paste located on a region outside the narrow parts of the electrodes 2 and 2 jointed to the wiring patterns 1 and 1 is attracted to the electrodes 2 and 2 and uniformly spread over them, whereby the electrodes 2 and 2 are shortcircuited by molten solder 4.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平6-232537

(43)公開日 平成6年(1994)8月19日

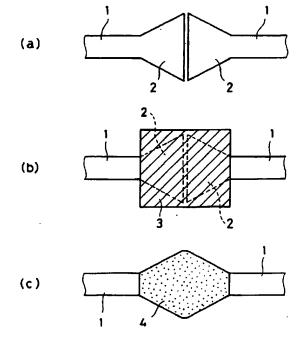
(51) Int.Cl. <sup>5</sup> H 0 5 K 3/22 H 0 1 L 21/82 23/12	識別配母 A	庁内整理番号 7511-4E	FI			技術表示箇所	
		9169-4M	H01L	21/ 82 S			
		9355-4M		23/ 12	Q		
		審査請求	未請求請求功	頁の数1 OL	(全 4 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号	<b>特顧平5-15411</b>		(71)出顧人	000006231 株式会社村田9	製作所		
(22)出顧日	平成5年(1993)2月	5年(1993)2月2日 京都府長岡京市天神二丁				6番10号	
			(72)発明者	米澤 正雄			
				京都府長岡京市会社村田製作所		6番10号 株式	
			(72)発明者	守安 明義			
				京都府長岡京市	<b>市天神二丁目2</b>	6番10号 株式	
			1	会社村田製作用			
			(74)代理人	弁理士 岡田	和秀		

# (54) 【発明の名称】 閉回路形成用電極の短絡方法

## (57)【要約】

【目的】一対の閉回路形成用電極の短絡方法であって、 その短絡が確実におこなえるようにする。

【構成】配線バターンに接続されたその配線バターン側が狭くなるような形状の一対の閉回路形成用電極を所定のギャップをおいて対向するように形成し、その一対の閉回路形成用電極の上から、この電極よりも大きな面積を有する領域に半田ペーストを印刷し、この半田ペーストを加熱して溶融することにより前配一対の閉回路形成用電極をその溶融した半田で短絡する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上において、配線パターンに接続さ れたその配線パターン側が狭くなるような形状の一対の 閉回路形成用電極を所定のギャップをおいて対向するよ うに形成し、その一対の閉回路形成用電極の上からこの 電極よりも大きな面積を有する領域に半田ペーストを印 刷し、その半田ペーストを加熱して溶融することにより 前記一対の閉回路形成用電極をその溶融した半田で短絡 することを特徴とする閉回路形成用電極の短絡方法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ハイブリッドIC等の 複合回路部品において用いられる閉回路形成用電極の短 絡方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】ハイブリッドIC等の複合回路部品にお いて、たとえば閉回路中に接続されている抵抗体をトリ ミングしようとする場合、その抵抗体の抵抗値が単独で 測定できるようになっている必要がある。

【0003】ところが、閉回路中に他の抵抗体が接続さ 20 れていると、その抵抗体の抵抗値の影響をうけてトリミ ングしようとする抵抗体自身の抵抗値が測定できないた め、正確なトリミングが不可能となる。

【0004】そのため、そのトリミングをしようとする 抵抗体については、閉回路を形成する配線パターンの一 部をあらかじめ切断した状態にして他の抵抗体の影響を うけないようにしておき、トリミングが終了した後にそ の切断されている配線パターンを接続して閉回路を形成 するということが行われている。

【0005】このような閉回路の形成手段として、従来 30 から図3に示すような方法が採用されている。すなわ ち、図3 (a) に示すように、複合回路部品を形成する 基板上において、配線パターン11、11に接続された 矩形状の一対の閉回路形成用電極12、12を所定のギ ャップをおいて対向するように形成しておく。このまま ではいまだ閉回路が形成されていないので、たとえば抵 抗体のトリミングが可能な状態となっている。そして、 トリミング等が終了した後、図3 (b) に示すように、 一対の閉回路形成用電極12、12の上からその電極1 田ペースト13を印刷する。その後、半田ペースト13 を加熱して溶融すると、図3 (c) に示すように、溶融 した半田14によって閉回路形成用電極12、12が短 絡され、閉回路が形成される。

## [0006]

【発明が解決しようとする課題】一方、昨今、集積回路 等の基板上に搭載する電子部品のリードピッチのファイ ン化にともない、リード間で短絡の生じにくいファイン ピッチ用の半田ペーストが開発され、導入されてきてい る。

【0007】ところが、このような半田ペーストでは、 その半田ペーストの性質上、上記の閉回路形成用電板1 2、12間においても短絡が生じにくくなるため、確実 な閉回路の形成が困難となり、半田ごで等で手直しをし なければならないという問題が生じる。

【0008】したがって、本発明においては、上記のよ うなファインピッチ用の半田ペーストを用いた場合で も、閉回路形成用電極の短絡が確実におこなえるような 閉回路形成用電極の短絡方法を提供することを目的とし 10 ている。

### [0009]

【課題を解決するための手段】このような目的を達成す るため、本発明の閉回路形成用電極の短絡方法において は、配線パターンに接続されたその配線パターン側が狭 くなるような形状の一対の閉回路形成用電極を所定のギ ャップをおいて対向るすように形成し、その一対の閉回 路形成用電極の上からこの電極よりも大きな面積を有す る領域に半田ペーストを印刷し、その半田ペーストを加 熱して溶融することにより前記一対の閉回路形成用電極 をその溶融した半田で短絡することを特徴としている。

### [0010]

【作用】配線パターン側が狭くなるような形状の一対の 閉回路形成用電極を所定のギャップをおいて対向するよ うに形成し、その電極よりも大きな面積を有する領域に 半田ペーストを印刷したことにより、閉回路形成用電極 の配線パターン側の狭い部分の外側の領域にある半田ペ ーストが溶融されることによって閉回路形成用電板に引 き寄せられ、その電極面をつたって電極上に均一に広が っていく。そのため、その一対の閉回路形成用電板のギ ャップ付近の溶融半田量も多くなり、その一対の電極が 容易に短絡されることになる。

## [0011]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照して詳細 に説明する。

【0012】まず、基板上に配線パターンを形成すると きに、図1 (a) に示すように、配線パターン1、1に 接続されたその配線パターン1、1側が狭くなるような 形状の一対の閉回路形成用電極2、2を同時に形成して おく。この一対の閉回路形成用電極2、2は、たとえ 2.08 1 2 の周囲を取り囲むような面積を有する領域に半 40 ば、 $100 \mu m$ 程度の範囲内のギャップをおいて対向す るように形成される。

> 【0013】そして、抵抗体のトリミング等の所定の処 理が終了した後に、図1(b)に示すように、一対の閉 回路形成用電極2、2の上からこの電極2、2よりも大 きな面積を有する領域にファインピッチ用の半田ペース ト3を印刷する。

【0014】その後、半田ペースト3を加熱して溶融す ると、閉回路形成用電極2、2の配線パターン1、1側 の狭い部分の外側の領域にある半田ペースト部分も電極 50 2、2に引き寄せられて電極2、2上に均一に広がって

3

いき、図1 (c) に示すように、溶融した半田4により一対の電極2、2が短絡される。勿論、この溶融した半田4は次第に冷えて固化する。

【0015】なお、閉回路形成用電極2、2の形状は図2に示すようなものであってもよく、要は配線パターン1、1側が狭くなるようなものであればよい。また、閉回路形成用電極2、2を上配のように形成したことにより、従来からの半田ペーストを用いる場合であっても短絡が確実におこなわれるようになることはいうまでもない。

# [0016]

【発明の効果】以上説明したことから明らかなように本発明によれば、配線パターンに接続されたその配線パターン側が狭くなるような形状の一対の閉回路形成用電極を所定のギャップをおいて対向するように形成し、この一対の電極の上から、この電極よりも大きな面積を有する領域に半田ペーストを印刷するようにしたから、一対の閉回路形成用電極の短絡が確実におこなえるようになる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の閉回路形成用電極の短絡方法を説明するための図で、図1 (a) は閉回路形成用電極の平面図、図1 (b) は図1 (a) に示す閉回路形成用電極の上から半田ペーストを印刷した状態を示す図、図1 (c) は図1 (b) に示す半田ペーストを溶融した後の状態を示す図である。

【図2】本発明に用いる閉回路形成用電極の他の形状例 を示す図である。

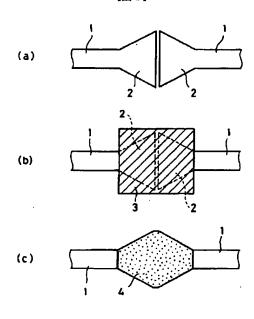
【図3】従来例の閉回路形成用電極の短絡方法を説明す
10 るための図で、図3 (a) は閉回路形成用電極の平面
図、図3 (b) は図3 (a) に示す閉回路形成用電極の
上から半田ペーストを印刷した状態を示す図、図3
(c) は図3 (b) に示す半田ペーストを溶融した後の
状態を示す図である。

## 【符号の説明】

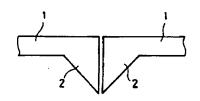
- 1 配線パターン
- 2 閉回路形成用電極
- 3 半田ペースト
- 4 溶融した半田

20

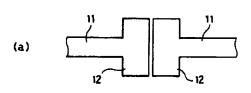


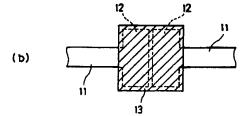


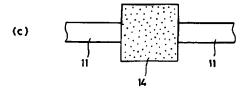
【図2】



[図3]







(4)

特開平6-232537

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内

庁内整理番号 9355-4M FΙ

H01L 23/12

技術表示箇所 H